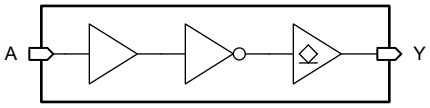
SN74LVC1G06B-Q1 車載、オープン ドレイン出力のシングル 1.1V ～ 5.5V インバータバッファ/ドライバ

1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
  - デバイス温度グレード 1:–40°C ～ +125°C
  - デバイス HBM ESD 分類レベル 2
  - デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 1.1V～5.5V の動作範囲
- V_{CC} とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
- V_{CC} とは無関係に、5.5V に耐えるオープン ドレイン出力
- バックドライブ保護 (I_{off}) 付きの部分的パワーダウンをサポート
- 優れたオープン ドレイン出力駆動能力:
  - 5V で 32mA
  - 3.3V で 24mA
  - 2.5V で 8mA
  - 1.8V で 4mA
- 最大伝搬遅延:2.6ns (5V、50pF 時)
- JESD78 と AEC AEC-Q100-004 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能

2 アプリケーション

- インジケータ LED の駆動
- オープン ドレイン出力を使用したレベル シフト



ロジック図

3 説明

SN74LVC1G06B-Q1 は、オープン ドレイン出力のシングルインバータです。SN74LVC1G06B-Q1 デバイスはブール関数 $Y = \overline{A}$ を正論理で実行します。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)	本体サイズ (3)
SN74LVC1G06B-Q1	DTX (X2SON、5)	1.1mm × 0.85mm	1.1mm × 0.85mm

(1) 詳細については、メカニカル、パッケージ、および注文情報 を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
(3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。

このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

目次

1 特長.....1
2 アプリケーション.....1
3 説明.....1
4 ピン構成および機能.....3
5 仕様.....4
5.1 絶対最大定格.....4
5.2 ESD 定格.....4
5.3 推奨動作条件.....5
5.4 熱に関する情報.....5
5.5 電気的特性.....6
5.6 スイッチング特性.....7
5.7 代表的特性.....8
6 パラメータ測定情報.....9
7 詳細説明.....10
7.1 概要.....10
7.2 機能ブロック図.....10
7.3 機能説明.....10
7.4 デバイスの機能モード.....11
8 アプリケーションと実装.....12
8.1 使用上の注意.....12
8.2 代表的なアプリケーション.....12
8.3 電源に関する推奨事項.....14
8.4 レイアウト.....14
9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....16
9.1 ドキュメントのサポート.....16
9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....16
9.3 サポート・リソース.....16
9.4 商標.....16
9.5 静電気放電に関する注意事項.....16
9.6 用語集.....16
10 改訂履歴.....16
11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....17

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

4 ピン構成および機能

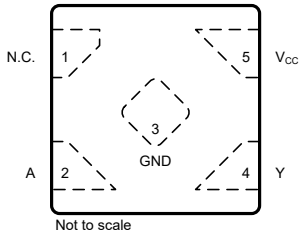


図 4-1. DTX パッケージ 5 ピン X2SON (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ(1)	説明
名称	番号		
A	2	I	入力
GND	3	G	グランド
N.C.	1	-	内部接続なし
V_{CC}	5	P	電源
Y	4	O	出力

(1) I = 入力、O = 出力、P = 電源、G = グランド

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧範囲		-0.5	6.5	V
V_I	入力電圧範囲(2)		-0.5	6.5	V
V_O	出力電圧範囲 - ハイ インピーダンス(2)		-0.5	6.5	V
I_{IK}	入力ダイオード クランプ電流	V_I < -0.5V		-50	mA
I_{OK}	出力ダイオード クランプ電流	V_O < -0.5V		-50	mA
I_O	連続出力電流、			50	mA
	V_{CC} または GND を通過する連続電流			±100	mA
T_J	接合部温度			150	°C
T_{stg}	保存温度		-65	150	°C

(1) 「絶対最大定格」外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、また「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件においても、本デバイスが動作することを暗黙に示すものではありません。推奨動作条件の範囲外でも、絶対最大定格の範囲内であれば、一時的な動作によってデバイスが損傷するとは限りませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。

(2) 入力電流と出力電流の定格を遵守していても、入力と出力の負電圧の定格を超える可能性があります。

5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 HBM ESD 分類レベル 2 準拠(1)	±2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、AEC Q100-011 CDM ESD 分類レベル C4B 準拠	±1000	

(1) AEC Q100-002 には、HBM ストレス試験は ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 仕様に従って実施することと規定されています。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

仕様	説明	条件	最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧		1.1	5.5	V
V_I	入力電圧		0	5.5	V
V_O	出力電圧 - ハイ インピーダンス		0	5.5	
I_{OL}(1)	Low レベル出力電流	V_{CC} = 1.2V		1	mA
		V_{CC} = 1.5V		4	
		V_{CC} = 1.8V		6	
		V_{CC} = 2.5V		16	
		V_{CC} = 3.3V		32	
		V_{CC} = 5V		50	
V_{IH}	High レベル入力電圧	V_{CC} = 1.1V～1.95V	0.65x V_{CC}		V
		V_{CC} = 2.3V～2.7V	1.7		
		V_{CC} = 3.0V～3.6V	2		
		V_{CC} = 4.5V～5.5V	0.7x V_{CC}		
V_{IL}	Low レベル入力電圧	V_{CC} = 1.1V～1.95V		0.35x V_{CC}	V
		V_{CC} = 2.3V～2.7V		0.7	
		V_{CC} = 3.0V～3.6V		0.8	
		V_{CC} = 4.5V～5.5V		0.3x V_{CC}	
Δt/Δv	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート	V_{CC} = 1.1V～2.7V		20	ns/V
		V_{CC} = 3.3V ± 0.3V		10	
		V_{CC} = 5V ± 0.5V		5	
T_A	自由空気での動作温度		-40	125	°C

(1) 連続動作の推奨最大出力電流。V_{OH} および V_{OL} の仕様を維持するためのテスト電流の値については、電気的特性を参照してください。32mA を超える平均出力電流で動作すると、デバイスの信頼性に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。

5.4 熱に関する情報

パッケージ	ピン	熱評価基準(1)						単位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(top)}$	$R_{\theta JB}$	Ψ_{JT}	Ψ_{JB}	$R_{\theta JC(bot)}$	
DTX (X2SON、5)	5	393.6	103.2	331.8	69.8	331.9	179.9	℃/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V_{CC}	–40°C ～ 125°C			単位
			最小値	標準値	最大値	
V_{OL}	I_{OL} = 100µA	1.1V ～ 5.5V			0.2	V
	I_{OL}= 4mA	1.65V			0.45	
	I_{OL}= 8mA	2.3V			0.3	
	I_{OL}= 12mA	2.7V			0.4	
	I_{OL}= 16mA	3V			0.4	
	I_{OL}= 24mA	3V			0.55	
	I_{OL}= 32mA	4.5V			0.55	
I_I	V_I = V_{CC} または GND	V_{CC} = 0V ～ 5.5V		±0.01	±5	µA
I_{OFF}	V_I または V_O = V_{CC}	V_{CC} = 0V		±0.1	±10	µA
I_{OZ}	V_O = V_{CC} または GND	5.5V		±0.1	±15	µA
I_{CC}	V_I = V_{CC} または GND、I_O = 0	V_{CC} = 1.1V～5.5V		0.01	10	µA
ΔI_{CC}	1 つの入力は V_{CC} - 0.6V、その他の入力は V_{CC} または GND	3.0V ～ 5.5V			500	µA
C_I	V_I = V_{CC} または GND	3.3V		3.5		pF
C_O	V_O = V_{CC} または GND	3.3V		6.3		pF

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.6 スイッチング特性

自由空気での動作温度範囲内、T_A = 25℃で測定した代表値 (特に記述のない限り)。「パラメータ測定情報」を参照

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	V_{CC}	–40°C ～ 125°C			単位
					最小値	標準値	最大値	
t_{pd}	A	Y	C_L = 15pF	1.2V ± 0.1V			28.7	ns
				1.5V ± 0.12V			6.8	
				1.8V ± 0.15V			4.8	
				2.5V ± 0.2V			3.1	
				3.3V ± 0.3V			2.4	
				5.0V ± 0.5V			2	
			C_L = 30pF	1.8V ± 0.15V			5.9	
				2.5V ± 0.2V			3.8	
			C_L = 50pF	3.3V ± 0.3V			3.5	
				5.0V ± 0.5V			2.6	
C_{pd}			f = 10MHz	1.8V		2		pF
				2.5V		2		
				3.3V		2		
				5.0V		3		

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.7 代表的特性

T_A = 25℃ (特に記述のない限り)

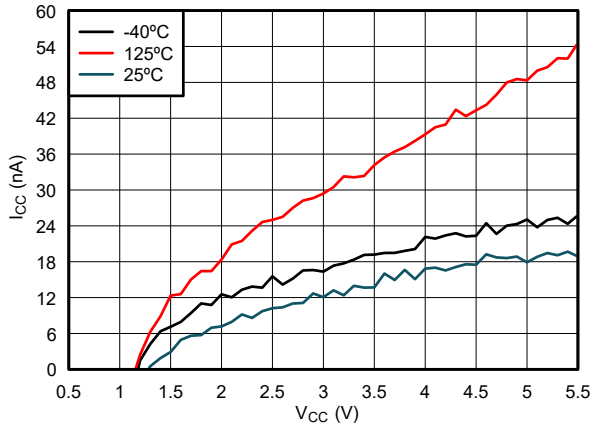


図 5-1. 電源電圧に対する電源電流と温度

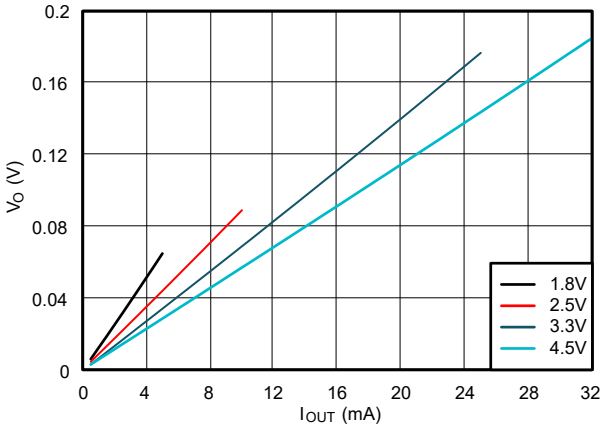


図 5-2. Low 状態における出力電圧と電流との関係

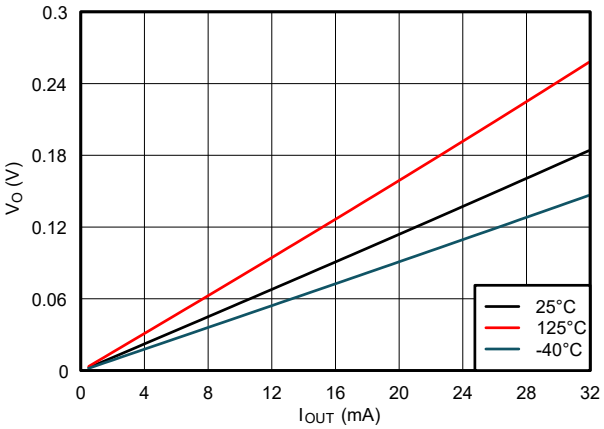


図 5-3. Low 状態における出力電圧と電流との関係、4.5V 電源

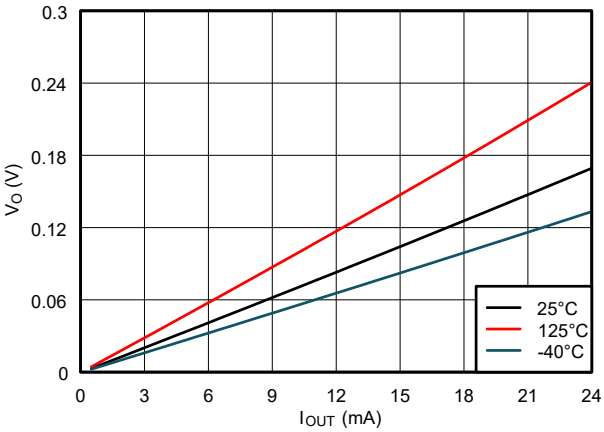


図 5-4. Low 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源

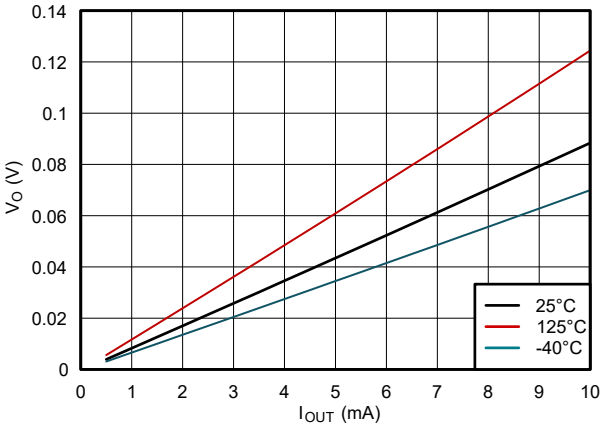


図 5-5. Low 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源

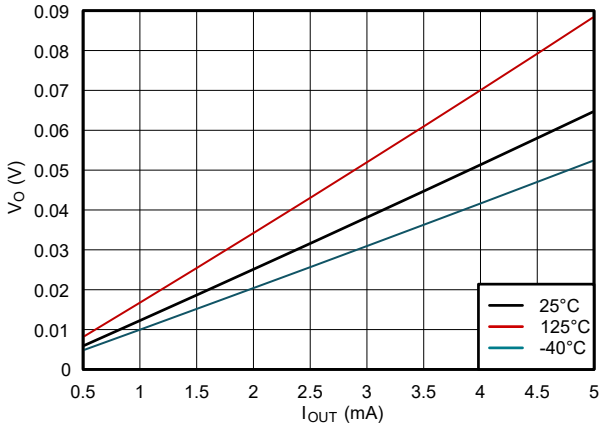


図 5-6. Low 状態における出力電圧と電流との関係、1.8V 電源

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

6 パラメータ測定情報

以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。次の特性を持つジェネレータにより、すべての入力パルスが供給されます。PRR ≦ 1MHz、Z_O = 50Ω、t_t ≦ 2.5ns。

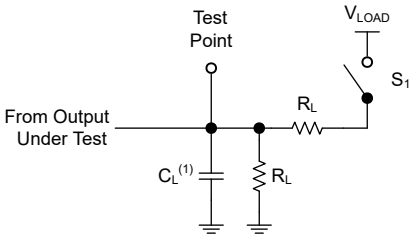
出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。

表 6-1. オープン ドレイン出力

TEST	S1
t_{PLZ}、t_{PZL}	クローズ

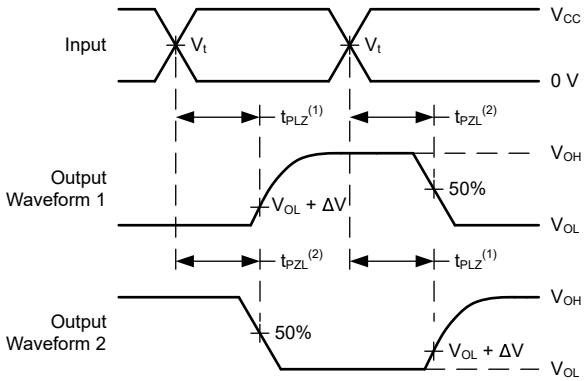
表 6-2. 3-state またはオープン ドレイン出力

V_{CC}	V_t	R_L	C_L	ΔV	V_{LOAD}
1.2V ± 0.1V	V_{CC}/2	2kΩ	15pF	0.1V	2 × V_{CC}
1.5V ± 0.12V	V_{CC}/2	2kΩ	15pF	0.1V	2 × V_{CC}
1.8V ± 0.15V	V_{CC}/2	1kΩ	15pF/30pF	0.15V	2 × V_{CC}
2.5V ± 0.2V	V_{CC}/2	500 Ω	15pF/30pF	0.15V	2 × V_{CC}
3.3V ± 0.3V	1.5V	500 Ω	15pF/50pF	0.3V	6V
5.0V ± 0.5V	1.5V	500 Ω	15pF/50pF	0.3V	6V



(1) C_L にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。

図 6-1. オープン ドレイン出力の負荷回路



(1) t_{PLZ} は t_{dis} と同じです。
(2) t_{PZL} は t_{en} と同じです。

図 6-2. 電圧波形、伝搬遅延

7 詳細説明

7.1 概要

SN74LVC1G06B-Q1 デバイスは、1 個のオープン ドレインインバータを内蔵しています。

7.2 機能ブロック図

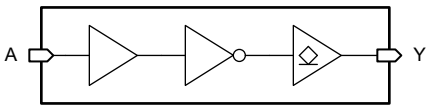


図 7-1. 論理図 (正論理)

7.3 機能説明

7.3.1 オープン ドレイン CMOS 出力

オープン ドレイン出力は SN74LVC1G06B-Q1 に含まれています。オープン ドレイン出力は、出力を Low にのみ駆動できます。ロジックが High で出力がハイ インピーダンス状態にある場合は、出力は電流のソースとシンクのどちらでもないことを意味します (ただし、「電気的特性」の表に定義されている小さなリーク電流は例外です)。ハイ インピーダンス状態では、出力電圧は SN74LVC1G06B-Q1 によって制御されず、外部要因に依存します。

ハイ インピーダンス状態であるため、ロジック High を定義するには外部プルアップ抵抗が必要です。プルアップ抵抗がないと、出力はフローティングになり、ロジック レベルは未定義になります。この抵抗値は、寄生容量や消費電力などの要因に依存します。通常は、10kΩ 抵抗が適しています。

SN74LVC1G06B-Q1 の駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リンギングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮してください。さらに、出力は SN74LVC1G06B-Q1 を連続的に処理するように設計されているよりも大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限します。*「絶対最大定格」*で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。SN74LVC1G06B-Q1 に外部から接続できる最大出力電圧については、「推奨動作条件」表を参照してください。

未使用のオープン ドレイン CMOS 出力は未接続のままにします。

7.3.2 部分的パワー ダウン (I_{off})

このデバイスには、電源ピンが 0V に保持されているときにすべての出力をディセーブルにする回路が搭載されています。ディスエーブルになっているときは、入力電圧に関係なく、出力は電流のソースとシンクのどちらも行いません。各出力のリーク電流の量は、「電気的特性」表の I_{off} 仕様によって定義されます。

7.3.3 標準 CMOS 入力

このデバイスには、標準 CMOS 入力が搭載されています。標準 CMOS 入力は高インピーダンスであり、通常は *電気的特性*に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 (R = V ÷ I) を使用して計算されます。

標準 CMOS 入力では、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されるように、有効なロジック状態間で入力信号を迅速に遷移させる必要があります。この仕様を満たさなければ、消費電力が過剰になり、発振を引き起こす可能性があります。詳細については、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』を参照してください。

動作中は、標準 CMOS 入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は V_{CC} または GND に終端させます。システムが常に入力を駆動していない場合は、有効な入力電圧を与えるために、プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を追加することを検討してください。抵抗値は複数の要因によって異なりますが、推奨される値である 10kΩ を使用すれば、通常はすべての要件を満たすことができます。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.3.4 クランプ ダイオード構造

図 7-2 は、このデバイスの入力と出力には負のクランプ ダイオードのみがあることを示しています。

注意

*絶対最大定格*表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

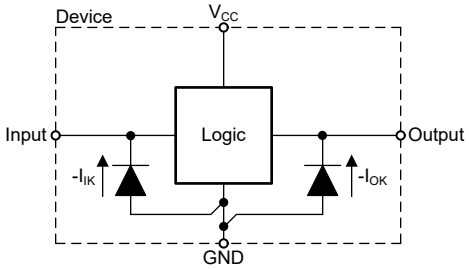


図 7-2. 各入力と出力に対するクランプ ダイオードの電気的配置

7.3.5 過電圧許容入力

SN74LVC1G06B-Q1 は、過電圧許容入力を備えています。入力ピンは、標準の正のクランプ ダイオードを備えていない入力保護回路を利用して、電源電圧よりも高い状態の入力電圧をサポートします。推奨入力電圧については、「推奨動作条件」を参照してください。

注意

「絶対最大定格」に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。最大入力電圧範囲定格を超えると、デバイスで即座に永続的な損傷が発生する可能性があります。

7.4 デバイスの機能モード

機能表 に、SN74LVC1G06B-Q1 の機能モードを示します。

表 7-1. 機能表

入力 A(1)	出力 Y(2)
L	Z
H	L

(1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル
(2) L = Low に駆動、Z = 高インピーダンス状態

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 使用上の注意

SN74LVC1G06B-Q1 は LED アプリケーションで使用できます。図 8-1 に、シンプルな LED ドライバアプリケーションを示します。

8.2 代表的なアプリケーション

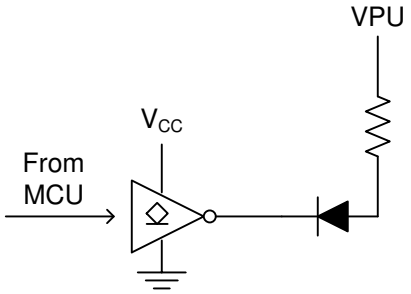


図 8-1. 代表的なアプリケーションの図

8.2.1 設計要件

8.2.1.1 電源に関する考慮事項

求める電源電圧が「電気的特性」で規定されている範囲内であることを確認します。「電気的特性」セクションに記載されているように、電源電圧はデバイスの電気的特性を設定します。

正電圧の電源は、、「電気的特性」に記載された静的消費電流 (I_{CC}) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流を供給できる必要があります。

グランドは、SN74LVC1G06B-Q1 のすべての出力によってシンクされる総電流、「電気的特性」に記載された消費電流 (I_{CC}) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流をシンクできる必要があります。ロジック デバイスは、グランド接続にシンクできる電流のみをシンクできます。「絶対最大定格」に記載された GND 総電流の最大値を超えないようにしてください。

SN74LVC1G06B-Q1 は、データシートの仕様をすべて満たしながら、合計容量 50pF 以下の負荷を駆動できます。これより大きな容量性負荷を印加することもできますが、過剰な電流を防止するため、出力とコンデンサの間に直列抵抗を設置することを推奨します。

SN74LVC1G06B-Q1 は、合計抵抗が $R_L \geq V_O / I_O$ で表される負荷を駆動することができ、出力電圧と電流は「電気的特性」表で定義されている V_{OL} を使用します。High 状態で出力する場合、この式の出力電圧は、測定した出力電圧と V_{CC} ピンの電源電圧の差として定義されます。

総消費電力は、CMOS の消費電力と Cpd の計算のアプリケーション ノートに記載された情報を使って計算できます。

温度の上昇は、標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性のアプリケーション ノートに記載された情報を使って計算できます。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

注意

「絶対最大定格」に記載された最大接合部温度、$T_{J(max)}$ は、本デバイスの損傷を防止するための追加の制限値です。「絶対最大定格」に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。これらの制限値は、デバイスへの損傷を防ぐために規定されています。

8.2.1.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、$V_{IL(max)}$ を超えるとロジック LOW と見なされ、$V_{IH(min)}$ を超えるとロジック HIGH と見なされます。*「絶対最大定格」*に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、V_{CC} またはグランドに終端させる必要があります。入力がまったく使用されていない場合は、未使用の入力を直接終端させることができます。入力が常時ではなく、時々使用される場合は、プルアップ抵抗かプルダウン抵抗と接続することも可能です。デフォルト状態が High の場合にはプルアップ抵抗、デフォルト状態が Low の場合にはプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SN74LVC1G06B-Q1 へのリーク電流 (「電気的特性」で規定)、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。こうした要因により 10kΩ の抵抗値がしばしば使用されます。

SN74LVC1G06B-Q1 は CMOS 入力を備えているため、正しく動作するには、「電気的特性」の表で定義されているように、速い入力遷移が必要です。入力遷移が遅いと発振が発生し、消費電力の増大やデバイスの信頼性の低下を招くことがあります。

このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」を参照してください。

8.2.1.3 出力に関する考慮事項

グランド電圧を使用して、出力 LOW 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「*電気的特性*」の V_{OL} 仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。

オープン ドレイン出力を互いに直接接続して、ワイヤード AND 構成を形成したり、出力駆動能力を高めることができます。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を V_{CC} またはグランドに直接接続しないようにしてください。

本デバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

8.2.1.4 詳細な設計手順

1. V_{CC} と GND の間にデカップリング コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ V_{CC} ピンと GND ピンの両方に電気的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
2. 出力の容量性負荷は、必ず 50pF 以下になるようにします。低負荷キャパシタンスは、SN74LVC1G06B-Q1 から受信デバイスまでのトレースを短く適切なサイズにすることで実現できます。
3. 出力の抵抗性負荷を $(V_{CC} / I_{O(max)})\Omega$ より大きくします。「絶対最大定格」の最大出力電流を超えないようにしてください。ほとんどの CMOS 入力は、MΩ 単位で測定される抵抗性負荷を備えています。これは、上記で計算される最小値よりはるかに大きい値です。
4. 熱の問題がロジック ゲートにとって問題となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、『CMOS 消費電力と CPD 計算のアプリケーション レポート』に記載されている手順を使用して計算できます。

8.2.2 アプリケーション曲線

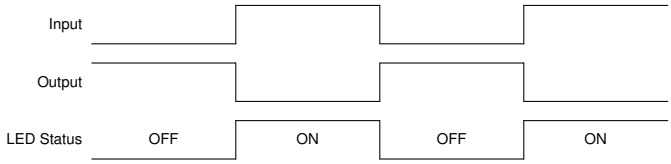


図 8-2. アプリケーション曲線

8.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の障害を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。

このデバイスには 0.1µF のコンデンサを推奨します。設計では、異なる周波数のノイズを除去するために、複数の並列バイパス コンデンサを組み込むことができます。一般的に、0.1µF と 1µF のコンデンサは並列に使用されます。最良の結果を得るため、バイパス コンデンサは電源端子にできるだけ近づけて配置してください。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

- バイパス コンデンサの配置
  - デバイスの正電源端子の近くに配置
  - 電気的に短いグランド帰還パスを提供
  - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
  - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
  - 8mil～12mil のトレース幅
  - 伝送ラインの影響を最小化する 12cm 未満の長さ
  - 信号トレースの 90° のコーナーは避ける
  - 信号トレースの下に、途切れのないグランド プレーンを使用
  - 信号トレース周辺の領域をグランドでフラッド フィル
  - 平行配線は、3 倍以上の誘電体厚で分離する必要があります
  - 12cm を超えるパターン用
    - インピーダンス制御トレースを使用
    - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
    - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8.4.2 レイアウト例

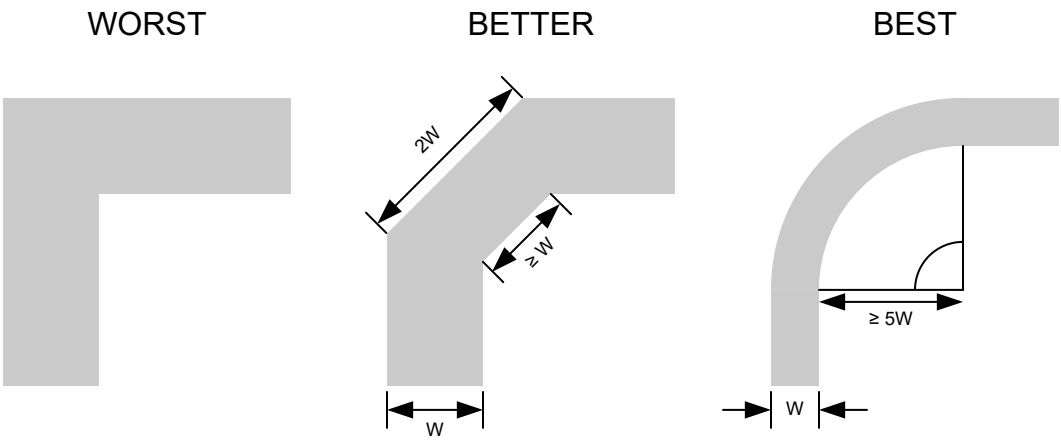


図 8-3. シグナル インテグリティ向上のためのサンプル パターンのコーナー

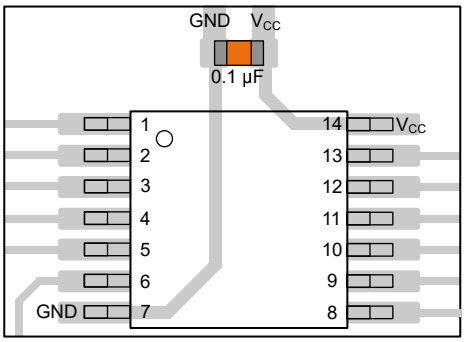


図 8-4. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

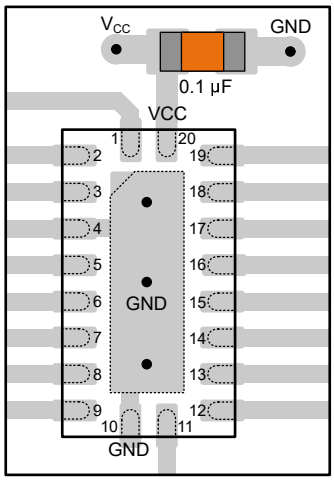


図 8-5. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

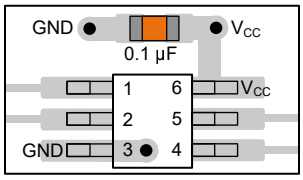


図 8-6. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

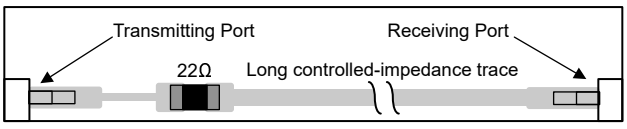


図 8-7. シグナル インテグリティ向上のためのダンピング抵抗の配置例

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『CMOS の消費電力と C_{pd} の計算』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『ロジック設計』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』アプリケーション ブリーフ
- テキサス・インスツルメンツ、『GTLP に重点を置いたライブ挿入アプリケーションでのロジック』アプリケーション ノート
- テキサス インスツルメンツ、『*半導体および IC パッケージの熱評価基準*』アプリケーション ノート SPRA953
- テキサス・インスツルメンツ、『テキサス・インスツルメンツの全般的品質ガイドライン』
- テキサス・インスツルメンツ、『SLL パッケージおよびデバイスの熱特性』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『シュミット トリガについて』アプリケーション ブリーフ

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集　　この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
September 2026	*	初版リリース

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

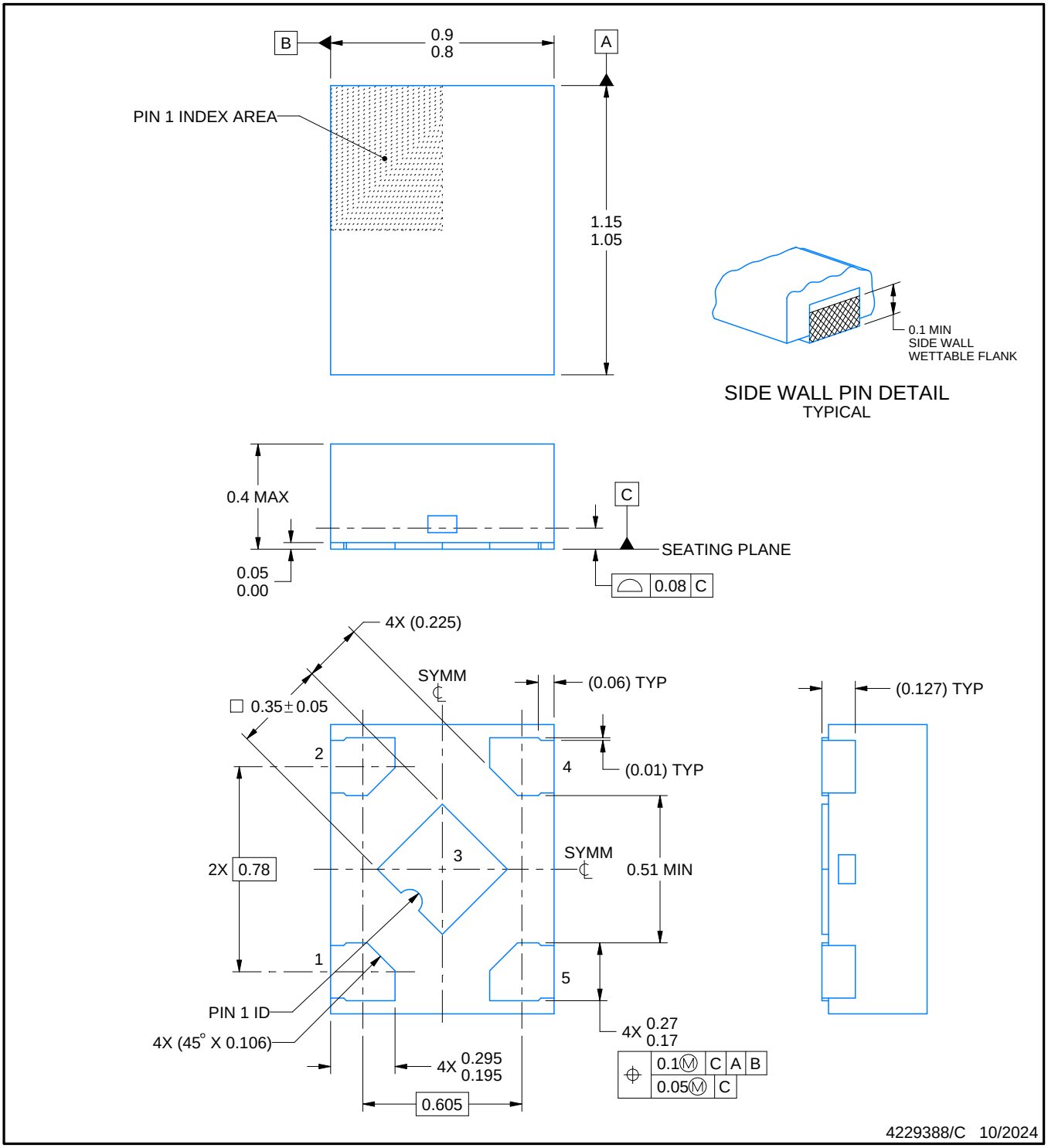
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

PACKAGE OUTLINE

DTX0005A

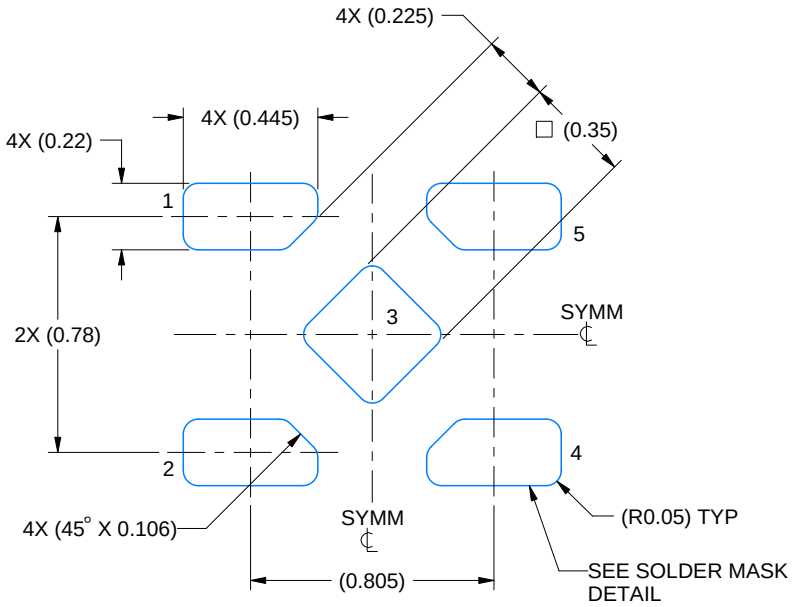
X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD

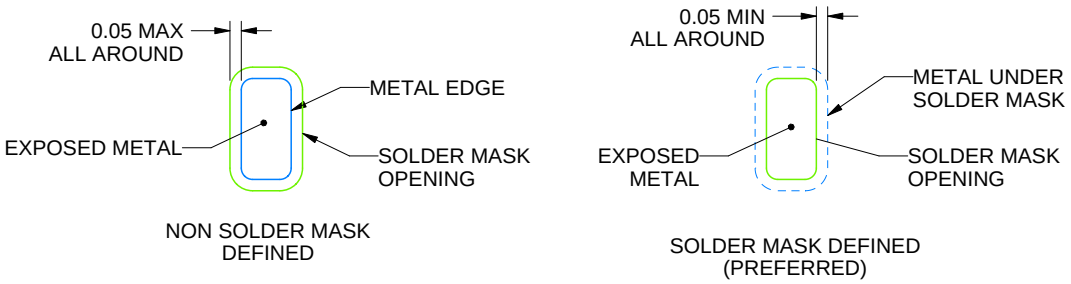


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 40X

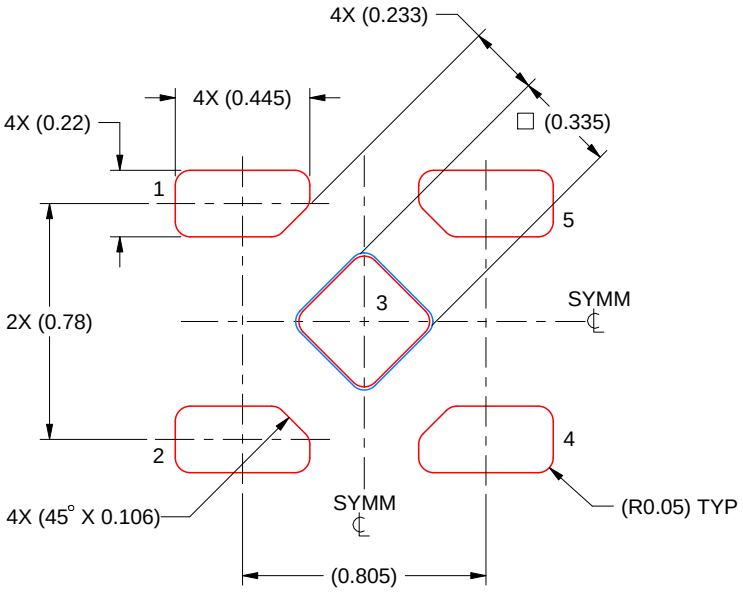


SOLDER MASK DETAILS

4229388/C 10/2024

NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE: 40X

PRINTED SOLDER PASTE COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
PAD 5: 92%

4229388/C 10/2024

NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、 TI の販売条件 、 TI の総合的な品質ガイドライン 、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月